

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0106U007992

Відкрита

Дата реєстрації: 22-08-2006

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 200

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

2. Замовник

Назва організації: Міністерство промислової політики України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00013942

Адреса: , м. Київ, Київ, 03035, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів

Телефон: 246-33-20

Телефон: 245-62-09

E-mail: info@industry.gov.ua

Інше: http:

Інше:

Інше: industry.kmu.gov.ua

3. Виконавець

Назва організації: Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23273999

Підпорядкованість: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Адреса: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Телефон: 2631065

E-mail: office@carat.electron.ua

4. Співвиконавець

Назва організації: Державний науково-дослідний центр "Фонон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 13675648

Адреса: , м. Київ, Київ, 03056, Україна

Підпорядкованість: Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності

Телефон: 246-38-11

Інше: 246-38-11

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розроблення технології виготовлення монокристалічних середовищ на основі епітаксійних структур гексаферитів для виготовлення мініатюрних і субмініатюрних керованих, пасивних компонентів надвисокочастотних приладів

Назва роботи (англ)

Development of fabrication technology for single crystal media on the base of hexaferrite epitaxial structures for production of miniature and sub-miniature controlled passive components of microwave devices

Мета роботи (укр)

Пошук та дослідження нових тонкоплівкових магнітних матеріалів з групи гексагональних феритів М-типу та розробка методів одержання на їх основі монокристалічних активних середовищ для перестроюваних пасивних НВЧ пристроїв мм-діапазону, придатних для використання планарних групових технологій. виготовлення.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Буде розроблена лабораторна технологія та виготовлені експериментальні зразки епітаксійних структур гексафериту М-типу з наступними параметрами: базовий хімічний склад епітаксійного шару - BaFe12O19; діаметр структури - не менше 30 мм; товщина магнітного епітаксійного шару - 5...15 мкм; ширина лінії феромагнітного резонансу (ФМР) в 8-мм діапазоні НВЧ - не більше 15 Е; намагніченість насичення (4πMs) - не менше 4000 Гс.

Галузь застосування:

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	07.2006	12.2006	Без звіту	Проведення технологічних експериментів по вирощуванню монокристалів з групи гексагалатів стронцію, легованих Mg та Zr, та дослідження їх характеристик. Розробка проекту технологічної інструкції на процес вирощування монокристалів.
2	01.2007	12.2007	Без звіту	Затвердження технологічної інструкції на процес вирощування монокристалів. Дослідження процесів механічної обробки монокристалів, виготовлення з них підкладок епітаксійної якості.
3	01.2008	12.2008	Остаточний звіт	Експериментальні дослідження та оптимізація режимів епітаксії плівок гексаферитів. Розробка технологічної інструкції на процес вирощування плівок гексаферитів. Одержання зразків плівок гексаферитів, дослідження їх параметрів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 61.69.37

Індекс УДК: 661:548.55; 661.539.1.074; 661.143, 621.315.21; 621.318.1

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Ваків Микола Михайлович (д. т. н., професор)

Керівники роботи:

Сиворотка Ігор Михайлович

Відповідальний за подання документів: (Тел.:)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.